

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
12. Mai 2005 (12.05.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 2005/042401 A1

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: B81B 7/00

(72) Erfinder; und

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2004/002413

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KNECHTEL, Roy  
[DE/DE]; Geraer Strasser 23, 98716 Geraberg (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:  
29. Oktober 2004 (29.10.2004)

(74) Anwälte: LEONHARD OLGEMOELLER FRICKE  
usw.; Postfach 10 09 62, 80083 Muenchen (DE).

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,  
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,  
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,  
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,  
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,  
ZW.

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

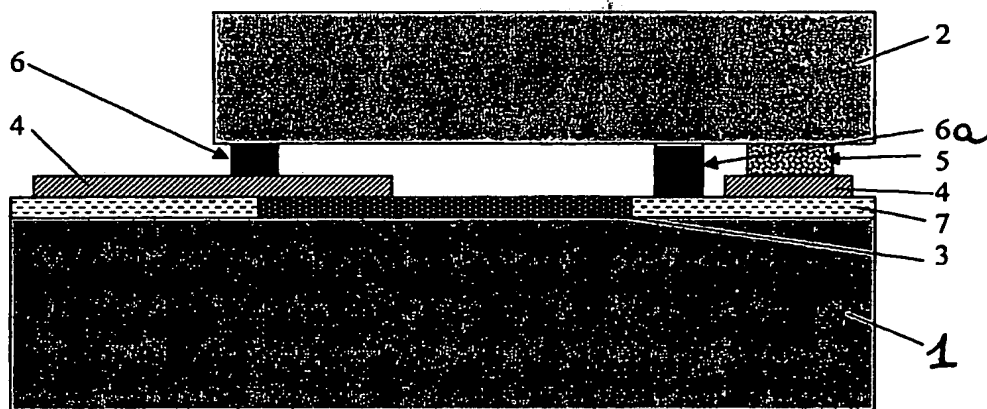
(30) Angaben zur Priorität:  
103 50 460.5 29. Oktober 2003 (29.10.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme  
von US): X-FAB SEMICONDUCTOR FOUNDRIES  
AG [DE/DE]; Haarbergstrasse 67, 99097 Erfurt (DE).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR SECURE, INSULATED AND ELECTRICALLY CONDUCTIVE ASSEMBLING OF  
TREATED SEMICONDUCTOR WAFERS

(54) Bezeichnung: FESTES ISOLIERENDES UND ELEKTRISCH LEITENDES VERBINDEN PROZESSIERTER HALBLEI-  
TERSCHREIBEN



(57) Abstract: The invention concerns a method and a device for assembling treated semiconductor wafers (1, 2), for obtaining not only a secure assembly, but an electrical connection (5) between the semiconductor wafers or between the electronic structures (3) comprising the latter as well. The invention is characterized in that the secure assembly is produced by means of structured intermediate glass layers (6; 6a), with low melting point, acting as insulating layers, and the electrical connection is produced by means of an electroconductive sealing glass (5).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine Anordnung der Verbindung von prozessierten Halbleiterscheiben (1,2), wobei zusätzlich zu dem festen Zusammenfügen eine elektrische Verbindung (5) zwischen den Halbleiterscheiben bzw. zwischen den diese tragenden elektronischen Strukturen (3) vorhanden ist. Dazu werden zwecks fester Verbindung niedrig schmelzende strukturierte Glaszwischenschichten (6; 6a) als Isolierschichten und als elektrische Verbindung in Form von elektrisch leitfähigem Lot (5) auf Glasbasis eingesetzt.

BEST AVAILABLE COPY

WO 2005/042401 A1